$Mu \rightarrow Mu$ 転換の探索に向けた Mu の真空への引き出し

京都大学理学部 2018 年度 課題研究 P2 冨永貴弘 辻川吉明 中川耕太郎 西田森彦

2018年12月24日

1 目的

1. Mu の生成率の測定

2. Mu が真空中に放出される割合の測定

3. $Mu \rightarrow \overline{Mu}$ 転換の探索(次年度以降)

2 背景

ミューオニウム Mu = (μ^+e^-) はレプトンのみで構成される水素様の原子である。Mu → Mu の転換はレプトンファミ リー数保存則を破る過程であり標準模型では禁止されるが、いくつかの beyond standard model では許容される。した がってその遷移確率 $P(Mu \rightarrow \overline{Mu})$ の上限を実験的に与えることには意味がある。我々は最終目標として Mu = (μ^+e^-)の転換を探索することを目的に実験を行う。

ところで、 $Mu \rightarrow \overline{Mu}$ の転換は、物質の作る外場によって $Mu \ge \overline{Mu}$ の縮退が解けると大きく抑制される。そのため $Mu \rightarrow \overline{Mu}$ 転換の探索のためには真空中に Mu を引き出す必要がある。そこで、今年度の実験では第1段階として Mu の生成割合を求め、次に第2段階として真空中へ放出された割合を求める。

3 装置

3.1 真空槽

真空槽本体

図 1 のような、SUS 製の異径十字継ぎ手。3 方向はカプトン箔の窓になっており、1 方向は真空ポンプを接続する アダプターになっている。1 月末に到着予定。

ディグレーダ・コリメータ

真空槽の直前に置く。ディグレーダは厚さ 0.6 mm のアルミ製、コリメータは内径 20 mm(長さ未定)の鉛製。

ターゲット台

SiO₂ ターゲットを支える部品。図 2 のように真空槽内にセットして使う。粉末試料とエアロジェルのうちどちら を使うかはまだ決まっていない。時間が許せば両方試したいと考えている。また、以前アドバイスを頂いた fused quartz も候補にある。

以下に記す検出器や磁場発生装置も含め、昨年度同様、装置はすべてレコフレームの上においた木製の天板の上に設 置する予定である。ただし真空槽の分昨年度に比べて重量が増しているので、必要に応じて天板をより丈夫なものに変 更することを検討している。



図 1: ターゲットを格納する真空槽。手前と左右のフランジはカプトン箔の窓になっており、手前から μ⁺ (青線)を入 射して左右で e⁺ (橙線)を検出する。奥のフランジは真空ポンプを接続するアダプターになっている。



図 2: 真空槽の断面図。左は SiO₂ 粉末標的を使う場合、右は SiO₂ エアロジェル標的を使う場合。真空槽の直前にある のはディグレーダ(薄い灰色)とコリメータ(濃い灰色)。コリメータの長さは未定である。

3.2 検出器

プラスチックシンチレータ (PS)

mSR/µSR に用いる。昨年度使用した全吸収型 PS(図 3)を 4 つに分解したものを使用する。1 つあたりの寸法は 200 mm × 200 mm × 60 mm。またその他に、ターゲット領域から飛来したことを保証するためのフィンガーカ ウンターも使用する。

シンチレーションファイバー (Sci-Fi)

e⁺ の1次元トラッキングに用いる。図4に示すように、1層目は直径1mmのSci-Fiを16本並べ、そのすぐ後 ろに 16 mm × 20 mm × 5 mm の PS を設置する。2 層目は1 層目のちょうど 2 倍の大きさのものを使う。





図 3: 昨年度使用したプラスチックシンチレータ。これを ファイバー(緑)の列の後ろにプラスチックシンチレー 4層に分解したものを使用する。

図 4: トラッキング用検出器の模式図。シンチレーション タ(白)を設置する。

3.3 モジュール

40 MHz 16ch Flash ADC (x3)

mSR/µSR に1個、トラッキングに3個用いる。

3.4 磁場発生装置

永久磁石

垂直方向に2Gの精度で127Gをかけるための永久磁石の組。昨年度の装置(図5)を参考に作成する。昨年度は60Gであったため、強度を2倍にする必要がある。現在検討中。

3 軸ヘルムホルツコイル (HC)

各軸 100 mG 精度で 2 G 程度出せるもの。水平方向の 2 軸は磁場を 100 mG 以下に抑えるために使う。垂直方向 の 1 軸は、mSR の際は 1.23 G の一様磁場をかけるため、μSR の際は永久磁石の磁場を微調整するために使う。

なお、1.23 G、127 G という値は、Mu あるいは μ^+ の Larmor 歳差運動がビームのバンチ間隔 580 ns でちょうど 1 周期となるように選んだ値である。



図 5: 昨年度使用した磁石。中央の銅板の位置に垂直方向に約 60 G の一様磁場を発生させる。

4 方法

4.1 Mu の生成率の測定

µSR 及び mSR により得られる asymmetry の振幅の比から生成率を求める。



図 6: mSR/µSR 実験装置の全体図。青線は µ⁺、橙線は e⁺ を表す。真空槽(薄い灰色)を囲むように 3 軸ヘルムホル ツコイルと永久磁石(共に濃い灰色)を設置する。真空槽から左右に 1 m 離れた位置にプラスチックシンチレータを設 置する。 実験装置の全体図を図 6 に示す。青線で示した μ^+ ビームがディグレーダ、コリメータを通って真空槽内部の SiO₂ 粉 末またはエアロジェルターゲットで止まり、Larmor 歳差運動を行った後崩壊する。

崩壊に伴う e⁺ (図中の橙線)は、左右それぞれ3層の PSの coincidence により検出する。1層目(フィンガー)は 真空槽のすぐそば、2層目はそこから1m離れた位置、3層目は2層目の奥に25mmのAlディグレーダを挟んで設置 する。これによりターゲット領域から飛来した比較的高エネルギーの e⁺ のみを検出することができる。

左右のカウント数 C_{L,R} を崩壊時間 t の関数としてヒストグラム化する。ここから左右の Asymmetry

$$Asym.(t) = \frac{C_L(t) - C_R(t)}{C_L(t) + C_R(t)}$$
(1)

を計算し、

 $f(t) = A\sin(\omega t + \delta) + a_0 + a_1 t + a_2 t^2$

でフィッティングする。最後に mSR と μ SR での Asym. の振幅 A から、Mu 生成率 R を

$$R = \frac{2A_{\rm Mu}}{A_{\mu} + 2A_{\rm Mu}}$$

で求める。

Toy Monte Carlo シミュレーションによると、1 時間のビーム照射の後、例えば図 7 のような結果が得られる(ただし Mu 生成率 R = 0.61を手で与えた)。*Asym.* のフィッティング結果は図 8 のようになり、 $R = 0.6106 \pm 0.0024$ と求まった。



図 7: Toy Monte Carlo シミュレーションによる左右のカウント数 C_{L,R}(t) の例。ビーム照射時間は1時間とした。この 図は垂直磁場 1.23 G のもの。



図 8: Toy Monte Carlo シミュレーションの結果から式 (1) で求めた非対称度 Asym. とそのフィッティング結果。左は 1.23 G (mSR)、右が 127 G (μ SR)。これらの結果から $R = 0.6106 \pm 0.0024$ と求まる(シミュレーションで与えた値 は R = 0.61)。

e⁺ をトラッキングすることにより Mu の真空への放出率を求める。

装置の構成は基本的に mSR/µSR のときと同じであるが、PS は撤去し、代わりにトラッキング用の検出器(図 4)を 2 層設置する(図 9)。また永久磁石もここでは使わず、磁場は 3 方向とも 100 mG 以下になるように調整する。



図 9: トラッキングの際のセットアップ(ただし真空槽本体は表示していない)。真空槽の横に図 4 の検出器を 2 層セットする。

1 層目、2 層目でそれぞれどの Sci-Fi を通ったかを記録し外挿することにより、崩壊位置の標的表面法線方向の1次 元分布を求める。真空への放出がある SiO₂ 粉末あるいはエアロジェル標的と、真空に放出されない標的(例えば Al、 fused quartz)とで比較し、テールに現れる差異から真空への放出率を求める。Toy Monte Carlo シミュレーションによ ると、図 10 のような結果が得られた。

分布の鈍りへの leading な寄与は µ⁺ ビームの左右方向への広がりだと考えている。そのため鉛ブロックを用いて縦長 スリット状のコリメータを構成することを検討している。例えば幅 2 mm のスリット状コリメータを使用すると、シミュ レーションでは図 11 のように鈍りが抑制された。ただしその分統計も減るため、最適な条件を現在検討中である。



図 10: Toy Monte Carlo シミュレーションで求めた μ^+/Mu の崩壊位置の1次元分布。内径20mmのコリ メータを通してビームを入射したもの。青線は真空への 放出がない場合、赤線は全 μ^+ の1%がMuとして真空 中に放出されたと仮定した場合を表す。なお、ターゲッ トのSiO₂ は -2mmから0mmの位置にある。



図 11: さらに 2 mm 幅の縦長スリットを通してビームを 入射した場合のシミュレーション結果。統計が減る代わ りに崩壊位置を正しく推定できるようになる。

4.3 必要機器

- SiO₂ 試料(粉末またはエアロジェル)
- 他 3 軸 HC 用電源装置
- ① ガウスメータ
- 真空ポンプ(10³Pa)
- PMT (mSR/µSR 用 10 本、トラッキング用 2 本、計 12 本)
- ① HV モジュール (10 個)
- 16ch Flash ADC x3
- Sci-Fi 用 MPPC x32
- MPPC 用電源
- NIM モジュール
- ① 19" ラック、NIM ビン、VME クレート
- Flash ADC の読み出し PC
- PC 用ディスプレイ

(①: J-PARC からお借りしたいもの、 (①: 京大化研 岩下さんからお借りするもの、 •: こちらで用意するもの)

- 4.4 スケジュール
- 2/15 昼12時頃到着、放射線講習
- 2/16 背景磁場の測定
 装置・回路組み立て、アラインメント
 HC の電流値調整
- 2/17 ビームタイム(9:00-21:00)
 ターゲットセット、真空引き
 テストラン、ビームを絞ってカウントレートを調整
 mSR/µSR(各1時間)
 Sci-Fi 設置、テストラン
 トラッキング1(1時間)
 標的取り替え、真空引き
 トラッキング2(1時間)
 2/18 撤収